

Низкие динамические потери
 Малый заряд обратного восстановления
 Разветвленный управляющий электрод для
 высоких скоростей нарастания тока

Быстродействующий Импульсный Тиристор Тип ТБИ273-2000-20

Средний прямой ток	I_{TAV}	2000 А
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	U_{DRM}	2000 В
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U_{RRM}	
Время выключения	t_q	32.0; 40.0; 50.0 мкс
U_{DRM} , U_{RRM} , В		2000
Класс по напряжению		20
T_j , °C		- 60 ÷ 125

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{TAV}	Средний ток в открытом состоянии	А	2000 2980	$T_c=85$ °C; двухстороннее охлаждение; $T_c=55$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии	А	3140	$T_c=85$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии	кА	40.0 46.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			42.0 48.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
I^2t	Защитный фактор	$A^2\cdot 10^3$	8000 10580	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			7320 9560	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс

Блокирующие параметры				
U_{DRM}, U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	2000	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
U_{DSM}, U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	2100	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто
U_D, U_R	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.75 \cdot U_{DRM}$ $0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\max}$; управление разомкнуто
Параметры управления				
I_{FGM}	Максимальный прямой ток управления	А	10	$T_j = T_{j\max}$
U_{RGM}	Максимальное обратное напряжение управления	В	5	
P_G	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	8	
Параметры переключения				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f=1$ Hz)	А/мкс	2500	$T_j = T_{j\max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; $I_{TM} = 2 I_{TAV}$; Импульс управления: $I_G = I_{FGM}$; $U_G = 20$ В; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt = 1$ А/мкс
Тепловые параметры				
T_{stg}	Температура хранения	°C	-60 ÷ 125	
T_j	Температура р-п перехода	°C	-60 ÷ 125	
Механические параметры				
F	Монтажное усилие	кН	40.0 ÷ 50.0	
a	Ускорение	м/с ²	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии

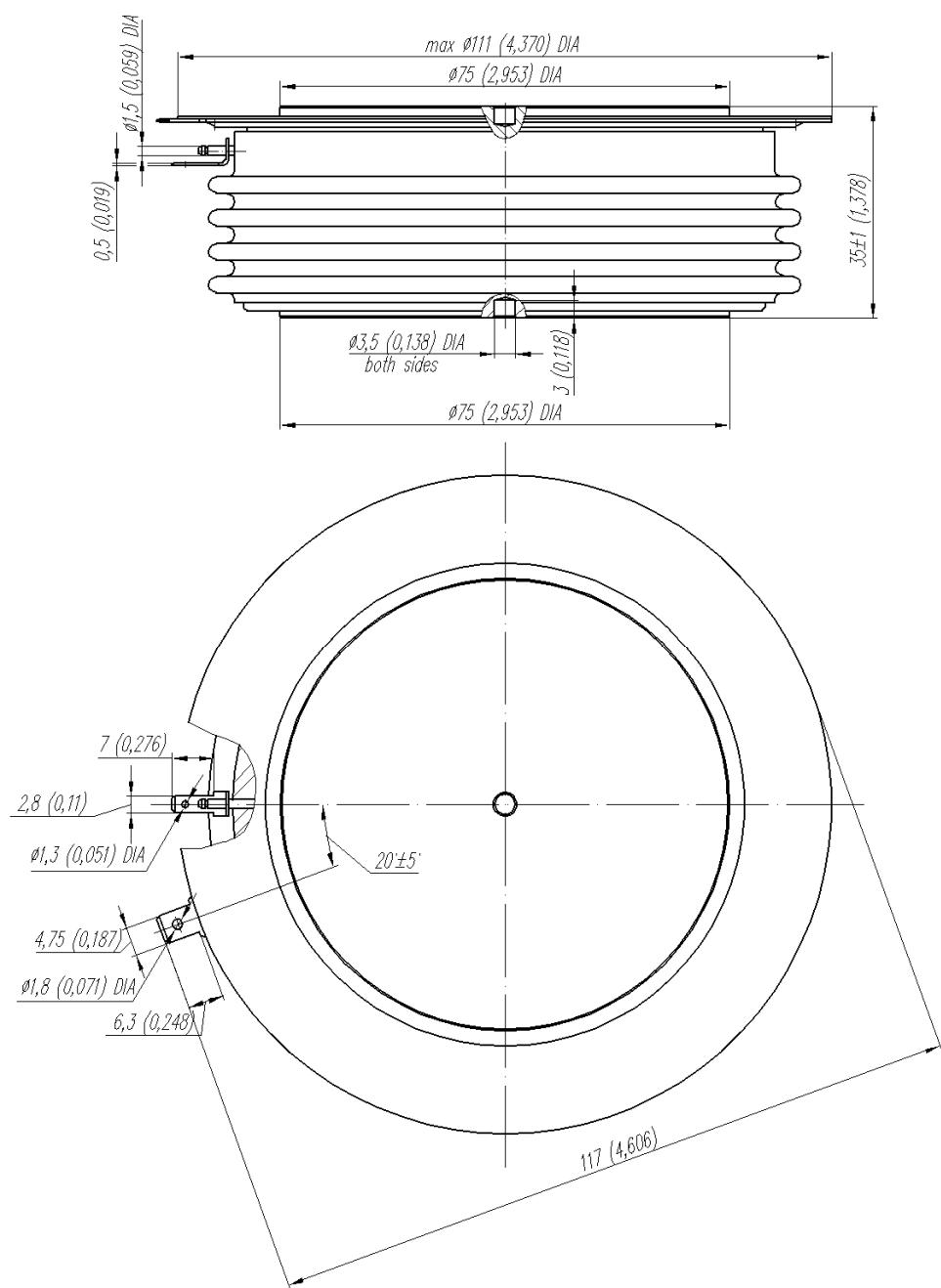
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики	Ед. изм.	Значение	Условия измерения
Характеристики в проводящем состоянии			
U_{TM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	2.20
$U_{T(to)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.25
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	0.150
I_H	Ток удержания, макс	мА	1000
			$T_j = 25$ °C; $U_D = 12$ В; управление разомкнуто
Блокирующие характеристики			
I_{DRM}, I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	300
$(dv_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии ¹⁾ , мин	В/мкс	1000
			$T_j = T_{j\max}$; $U_D = U_{DRM}$; $U_R = U_{RRM}$
			$T_j = T_{j\max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; управление разомкнуто

Характеристики управления											
U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	V	5.00 3.00 2.00	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = T_{j \max}$	$U_D = 12 \text{ В}; I_D = 3 \text{ А};$ Постоянный ток управления						
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, макс	mA	500 300 200	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = T_{j \max}$							
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	V	0.35	$T_j = T_{j \max};$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM};$	Постоянный ток управления						
I_{GD}	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	mA	15.00								
Динамические характеристики											
t_{gd}	Время задержки включения	мкс	2.5	$T_j = 25^{\circ}\text{C}; V_D = 0.4 \cdot U_{DRM}; I_{TM} = I_{TAV};$ Gate pulse: $I_G = I_{FGM}; V_G = 20 \text{ В};$ $t_{GP} = 50 \mu\text{s}; di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$							
t_q	Время выключения ²⁾ , макс	мкс	32.0; 40.0; 50.0	$dv_D/dt = 50 \text{ В}/\text{мкс};$	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di_R/dt = -10 \text{ А}/\text{мкс};$ $U_R = 100 \text{ В};$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$						
			40.0; 50.0; 63.0	$dv_D/dt = 200 \text{ В}/\text{мкс};$							
Q_{rr}	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	800	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di_R/dt = -50 \text{ А}/\text{мкс};$ $U_R = 100 \text{ В}$							
t_{rr}	Время обратного восстановления, макс	мкс	8.0								
I_{rrM}	Ток обратного восстановления, макс	A	200								
Тепловые характеристики											
R_{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	°C/Вт	0.0100	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение						
R_{thjc-A}			0.0220		Охлаждение со стороны анода						
R_{thjc-K}			0.0180		Охлаждение со стороны катода						
R_{thck}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	°C/Вт	0.0020	Постоянный ток							
Механические характеристики											
w	Масса, тип	г	1600								
D_s	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	55.13 (2.170)								
D_a	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	25.10 (0.988)								
ПРИМЕЧАНИЕ			МАРКИРОВКА								
1) Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии			ТБИ	273	2000	20	A2	K3	УХЛ2		
			1	2	3	4	5	6	7		
Обозначение группы	A2		1. Быстродействующий импульсный тиристор								
$(dv_D/dt)_{crit}, \text{В}/\text{мкс}$	1000		2. Конструктивное исполнение								
2) Время выключения ($dv_D/dt = 50 \text{ В}/\text{мкс}$)			3. Средний ток в открытом состоянии, А								
			4. Класс по напряжению								
Обозначение группы	K3	H3	E3	5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии							
$t_q, \text{мкс}$	32.0	40.0	50.0	6. Группа по времени выключения ($dv_D/dt = 50 \text{ В}/\text{мкс}$)							
				7. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т							

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: T.F5



Все размеры в миллиметрах (дюймах)